

ICEMOS Technology SOI Solutions



はじめに

ICEMOS はベルファスト工場(旧 BCO テクノロジー社)にてワールド・クラスのカスタム IC ソリューションを10年以上提供してきました。

高度な技術を持つ我々のチームは、SOI のデザインや製造に長年の経験を持ち、お客様の要求にあった SOI ソリューションを開発するお手伝いをいたします。R&D のための少量試作から月に何千単位以上の量産まで、お客様のご希望にあわせて対応させていただきます。

ICEMOS テクノロジーは、ワールドクラスの製品の品質、他社に負けない価格設定、そして迅速な工程サイクルにより、皆様の理想的な SOI パートナーとなります。

アプリケーション

我々のカスタム SOI ソリューションは以下の分野で使われます：

- MEMS/MST 向けの SOI ソリューション
- バイオ MEMS
- RF MEMS
- 光電子工学
- スマート・パワー
- アドバンスド・アナログ IC

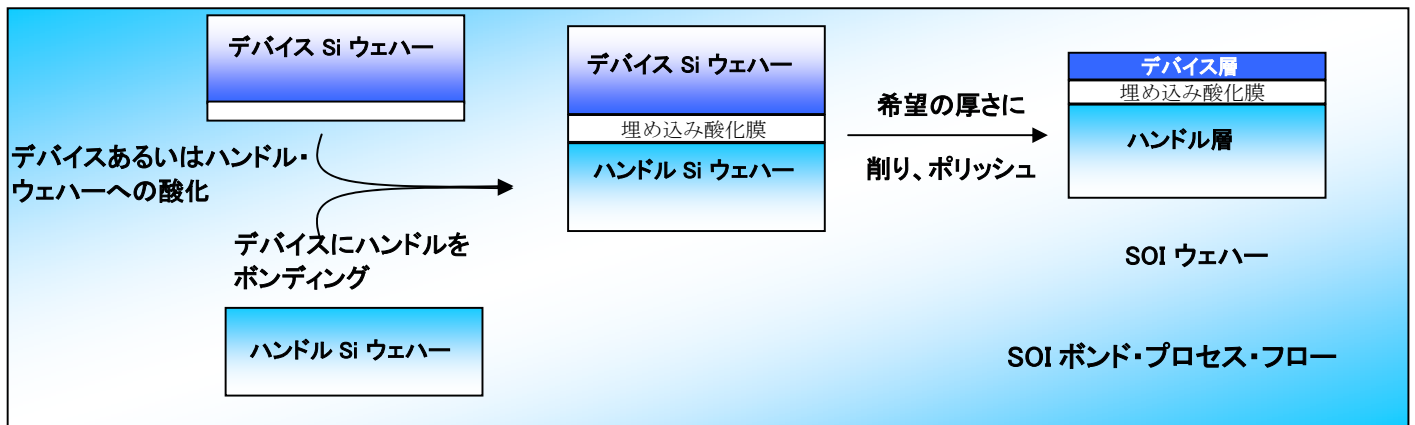
エンド市場

- テレコミュニケーション
- 医療関係
- 自動車関係
- コンシューマー
- 計器

ICEMOS Technology Ltd

5 Hannahstown Hill, Belfast BT17 0LT, United Kingdom
Phone +44 2890 574730
Fax +44 2890 574746

ICEMOS Technology SOI Solutions



パラメーター	単位	仕様範囲
ウェハー直径	Mm	100, 125, 150
ハンドル層の仕様		
ハンドルの厚さ	μm	350 - 700
ハンドルの厚さの公差	μm	+/- 5
ドーパントのタイプ		N 型あるいは P 型
ドーピング処理		N 型: Sb, As, P; P 型: B
抵抗率	Ω-cm	>0.007
成長方法		CZ あるいは FZ
結晶面方位		<100> あるいは <111>
バックサイドのフィニッシュ		ラップ/エッチングあるいはポリッシュ
埋め込み酸化膜の仕様		
熱酸化された埋め込み酸化膜の厚さ	μm	ハンドル、デバイス、あるいは両ウェハー上に 0.2 - 4.0 成長
デバイス層の仕様		
デバイス層の厚さ	μm	2 - 200
公差	μm	+/- 0.5 あるいは +/- 1
ドーパントのタイプ		N 型あるいは P 型
ドーピング処理		N 型: Sb, As, P; P-Type: B
抵抗率	Ω-cm	>0.007
成長方法		CZ あるいは FZ
結晶面方位		<100> あるいは <111>
埋め込み層インプラント		N 型あるいは P 型

ICEMOS Technology Ltd

5 Hannahstown Hill, Belfast BT17 0LT, United Kingdom
Phone +44 2890 574730
Fax +44 2890 574746